



新闻动态

- ▶ 图片新闻
- ▶ 头条新闻
- ▶ 综合新闻
- ▶ 学术活动
- ▶ 科研动态
- ▶ 通知公告
- ▶ 业内信息
- ▶ 合作交流

现在位置: [首页](#) > [新闻动态](#) > [综合新闻](#)

原子层沉积设备技术荣获“第八届（2013年度）中国半

2014-04-09 | 编辑: 八室 李楠 张艳清 | [【大 中 小】](#) |

日前,“2014年中国半导体市场年会”在无锡举行,微电子研发的原子层沉积设备技术荣获“第八届(2013年度)中国半电子设备技术研究室主任夏洋出席并领奖。

“第八届(2013年度)中国半导体创新产品和技术”评选活动、中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国积设备技术在内的8项半导体设备被评选为“2013年度中国半

原子层沉积设备技术为国家科技重大专项02专项项目“32设备技术探索”成果之一,研制产品针对32 nm以下技术代原子应的高K栅介质工艺验证及新材料制备工艺进行探索。该机型有均匀性好、技术指标广泛可调、使用范围广等特点。设备可底沉积温度范围25-450℃,温度均匀性±2-3℃,沉积速度为0.%,可用于TiO₂、Al₂O₃、HfO₂、ZnO、氮掺杂二氧化钛薄膜沉积。该技术在国内外相关期刊发表论文十余篇,申请专利73项,发明专利3项、国际发明专利4项,可有效地通过专利形成技术保护。

该设备技术的研制成功,一方面可以积累相关的核心知识充分的准备;另一方面其研制的原理机结构设计简洁,具有体积小,维护方便,可满足绝大多科研单位的需求,因此在研制型设备的市场化。

该设备研制完成后通过专利转让,经嘉兴科民电子设备开发,成功实现了20台ALD设备的销售,销售额达到900多万元清华大学、厦门大学、中科院上海微系统所等国内高校研究经济效益,在行业内具有了一定的影响。

原子层沉积系统

